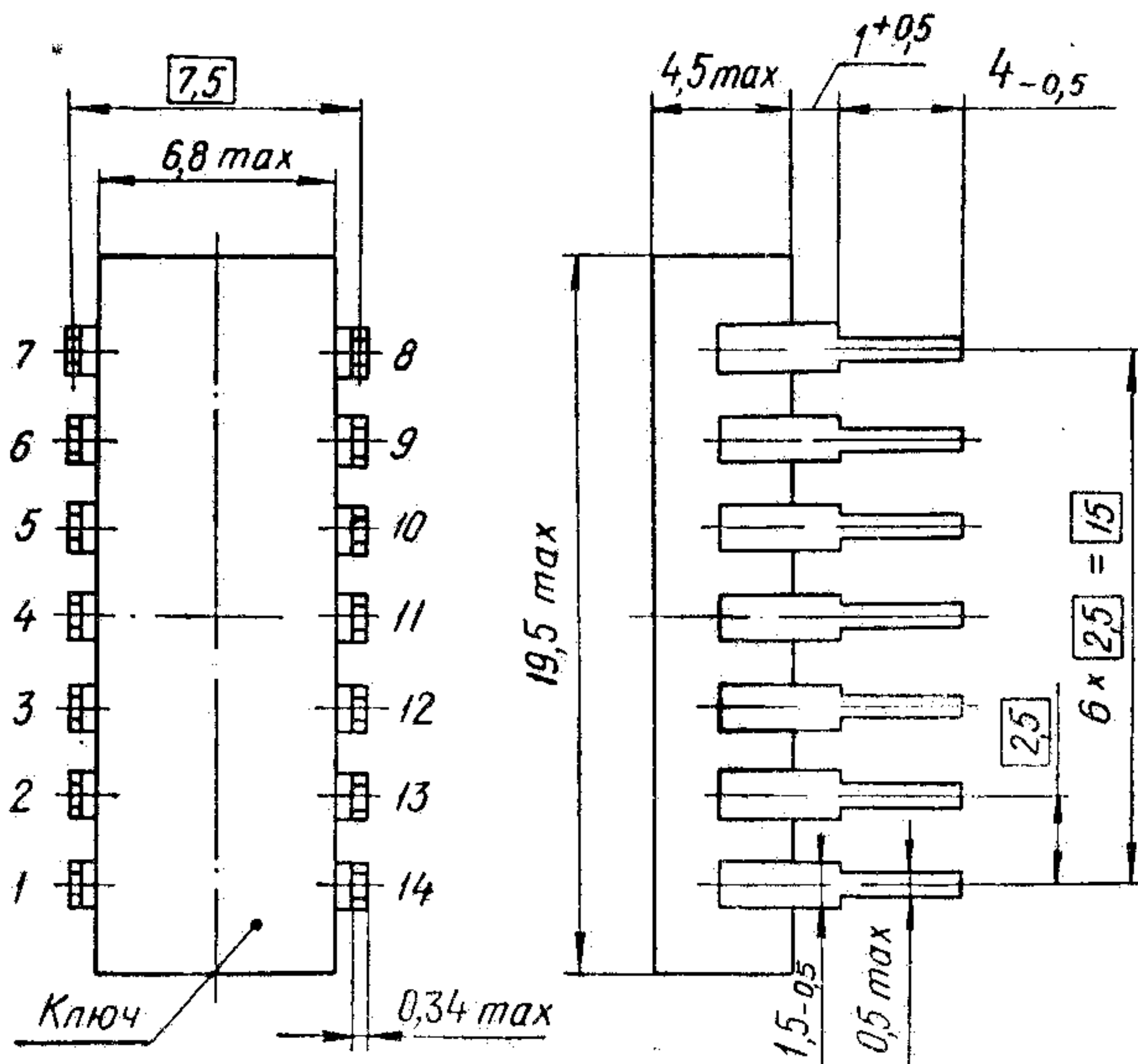


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР140

Общие данные

Микросхемы выполнены в прямоугольных корпусах 201.14-1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМ КР140УД6



Масса не более 1,1 г

Смещение осей выводов от номинального расположения $\pm 0,1$ мм (допуск зависимый). Нумерация выводов микросхем показана условно.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР140

Общие данные

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	1—2000
амплитуда ускорения, м/с ² (g)	200 (20)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с ² (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	0,1—2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с ² (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	1—5

Линейное ускорение, м/с² (g)

5000 (500)

Повышенная рабочая температура среды, °С

70

Пониженная рабочая температура среды, °С

минус 10

Изменение температуры среды, °С от минус 10 до +70

Повышенная относительная влажность при температуре 35 °С без конденсации влаги, %

98

Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)

2664 (200)

Атмосферное повышенное давление, Па (кгс/см²)

294 199 (3)

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч

15 000

Срок сохраняемости*, лет

12

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 18725—83 и требованиями, изложенными ниже.

Пайку выводов микросхем проводят, применяя припой ПОС-61 и флюс ФКСп. Запрещается подводить какие-либо электрические сигналы (в том числе подключать к шинам «питание» и «земля») к корпусу и к выводам микросхем, не используемым согласно электрической принципиальной схеме.

При проверке параметров устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений необходимо при отсутствии питающих напряжений на выводах контактного устройства.

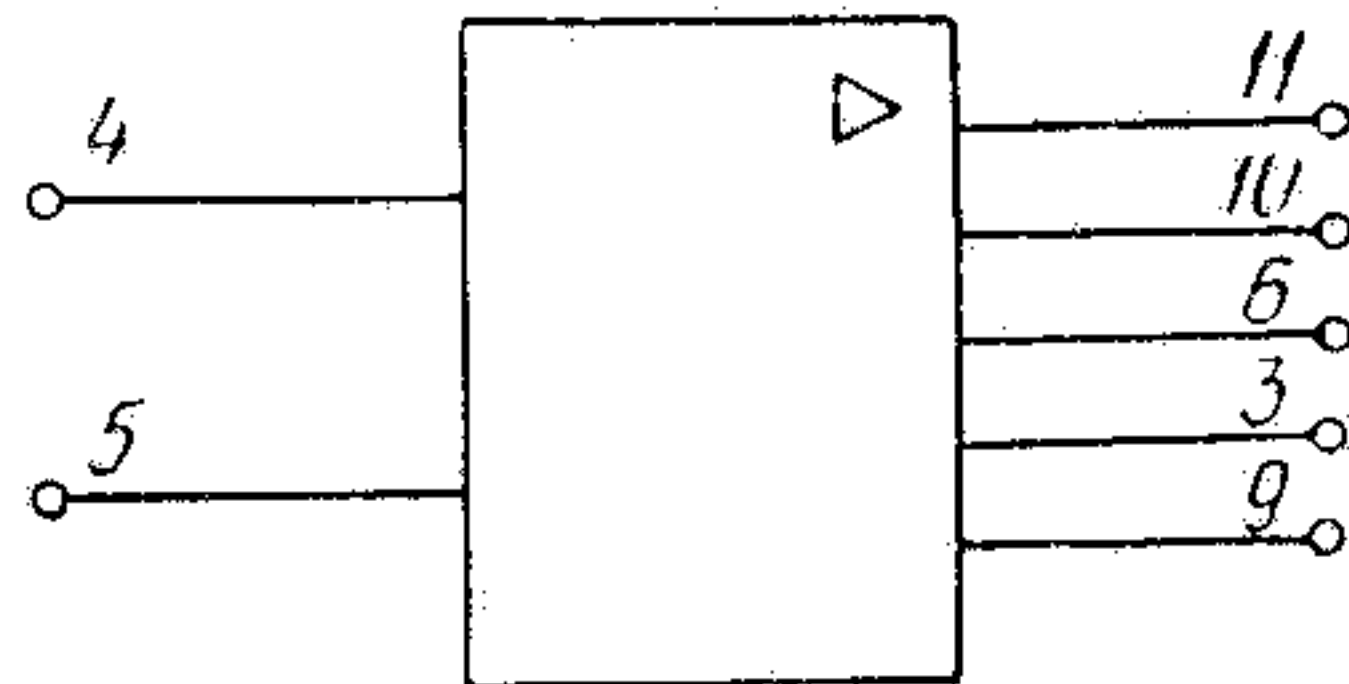
Монтаж и демонтаж микросхем проводить только при отключенных источниках питания.

В процессе эксплуатации микросхем необходимо принимать меры защиты их от воздействия статических зарядов.

Допустимое значение статического потенциала на выводах микросхемы 100 В.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

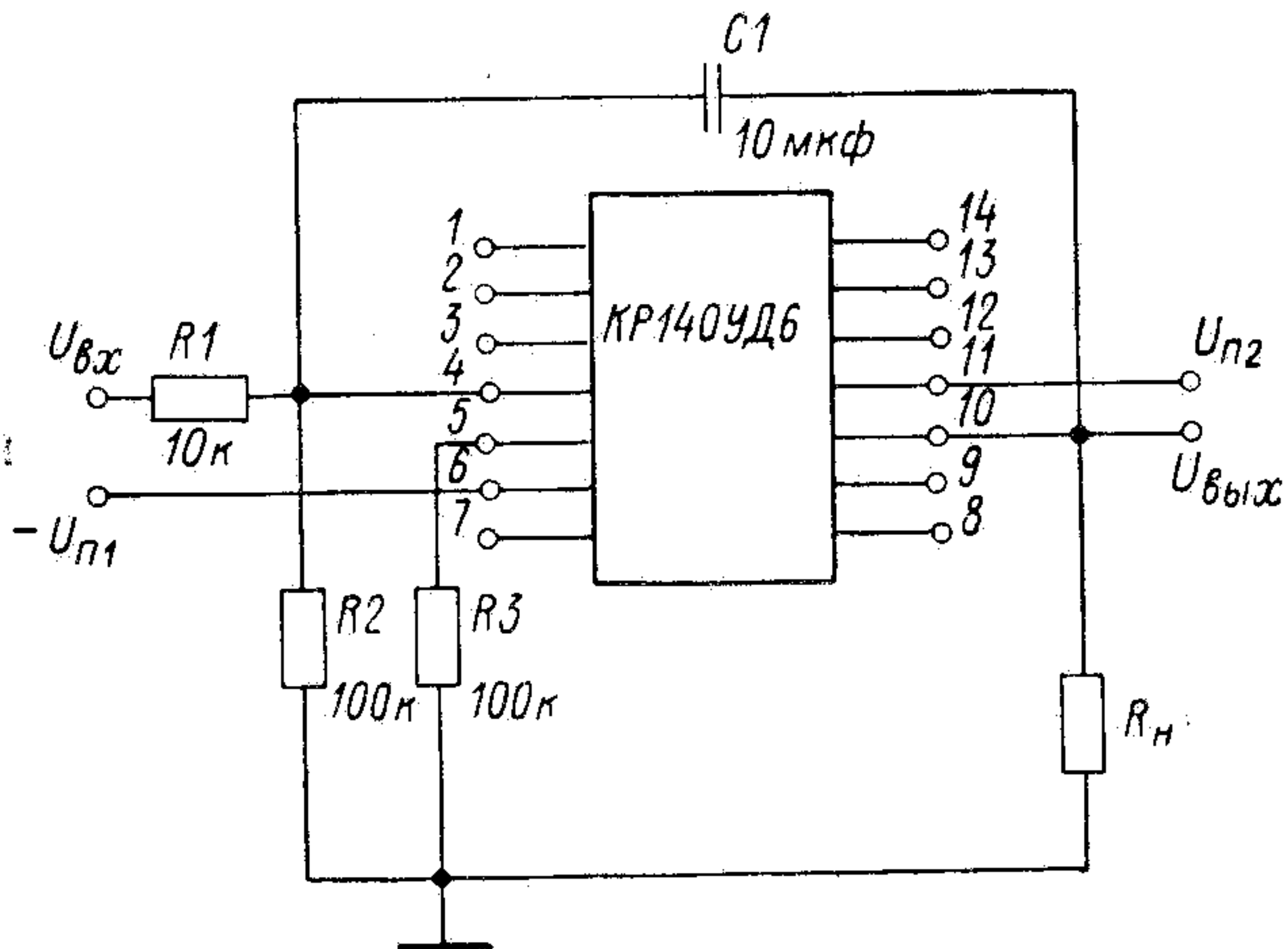
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



1, 2 — свободные
 3 — балансировка
 4 — вход инвертирующий
 5 — вход неинвертирующий
 6 — минус 15 В

7, 8 — свободные
 9 — балансировка
 10 — выход
 11 — 15 В
 12—14 — свободные

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(при температуре 25°C)

Напряжение питания, В:	
$U_{п1}$	мшус 15
$U_{п2}$	15
Ток потребления, мА, не более	4
Входной ток, нА, не более	100
Разность входных токов, нА, не более	25
Максимальное выходное напряжение, В, не менее	11
Напряжение смещения, мВ, не более	± 10
Частота среза, МГц, не менее	0,35
Коэффициент усиления напряжения, не менее . .	30 000
Коэффициент ослабления синфазных входных на- пряжений, дБ, не менее	70
Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения, мкВ/В, не более .	200
Входное сопротивление, МОм, не менее	1
Максимальная скорость нарастания выходного на- пряжения, В/мкс, не менее	0,5

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Напряжение питания, В:	
максимальное	± 18
минимальное	± 5
Максимальное входное (дифференциальное) напря- жение, В	30
Максимальное синфазное входное напряжение, В	± 15
Максимальное напряжение на каждом входе отно- сительно общей точки, В	15
Минимальное сопротивление нагрузки, кОм	1
Максимальная емкость нагрузки, пФ	100